

94-0008

Rezumat:

Invenția se referă la tehnologia semiconductorilor și poate fi utilizată pentru obținerea straturilor epitaxiale de fosfură de indiu crescută prin procedeul de cloruri cu parametri electrofizici reproductibili.

Ameliorarea calității și sporirea reproductibilității parametrilor electrofizici în cadrul procedurii de creștere a straturilor epitaxiale $A^{III}B^V$ în sistem de cloruri, ce include pregătirea accesoriilor, decaparea chimică a substraturilor, suflarea cu hidrogen a reactorului, termostatarea clorurii, încălzirea sursei și a substraturilor, decaparea gazoasă a substraturilor, creșterea straturilor subțiri, se efectuează decaparea gazoasă repetată a stratului crescut cu creșterea lui ulterioară.

Rezultatul tehnic al invenției constă în decaparea gazoasă repetată a stratului crescut cu creșterea lui ulterioară.

Revendicări: 1